

① 日本国特許庁 (JP)

② 特許出願公開

③ 公開特許公報 (A)

昭56-46573

④ Int. Cl.³
H 01 L 33/00
G 02 B 5/14

識別記号

⑤ 庁内整理番号
7739-5F
7529-2H

⑥ 公開 昭和56年(1981)4月27日

⑦ 発明の数 1
⑧ 審査請求 未請求

(全 2 頁)

⑨ 光ファイバー用半導体光装置

⑩ 株式会社日立製作所生産技術研究
所内

⑪ 特 願 昭54-120869

⑫ 出 願 人 株式会社日立製作所

⑬ 出 願 昭54(1979)9月21日

東京都千代田区丸の内1丁目5

⑭ 発 明 者 森 悟

番1号

横浜市戸塚区吉田町292番地株

⑮ 代 理 人 弁理士 秋本正実

明 細 書

⑯ 発明の名称 光ファイバー用半導体光装置

⑰ 特許請求の範囲

多層エピタキシャル層を備えた発光ダイオード
において、前記発光ダイオードに、少なくともその
発光領域以上の面積を底辺部に有する円錐形の結
合器を密着せしめ、その結合器と、これに接続す
る光ファイバーコアとを同一の屈折率を有する材
料で構成し、これらをスライシングにより、永
久接続することを特徴とする光ファイバー用半導
体光装置。

⑱ 発明の詳細な説明

本発明は、光通信用の発光ダイオードと、これ
に接続する光ファイバーとの結合用半導体光装置
に関するものである。

電気的な情報信号を発光ダイオードで光情報信
号に変換し、光ファイバークーブルを媒体として
伝送し、受光PINダイオードで再び電気的情報信
号に変換する光伝送装置は、大容量の情報伝送が
可能で、耐誘導雑音性に優れているところから、

各種の用途への適用が期待されている。然しなが
ら、前記光伝送装置の送信部において、発光ダイ
オードから放射状に出力される光情報信号を100
μm程度の媒体光ファイバーコア部に直接投入す
ることは非常に困難であり、そのために伝送可能
な情報量は大巾に制限されている。

前記した困難な問題に対し、従来から種々の対
策が提案されている。例えば(1)球状の一部を切断
した形状の放射器を構成し、これを媒体としてダ
イオードとファイバーを結合する方法(特開昭51
-87984)、(2)ダイオードの発光領域中心部に嵌
合せられた球状レンズを媒体としてファイバーに
結合する方法(特開昭53-4489)、(3)発光素子内
部に電圧制限領域を設けて、発光部分の面積を限
定し、高発光密度の光を出力する方法(特開昭53
-3784)、(4)固定基材に使用する接着剤の影響を
なくする方法(特開昭53-49975)等がある。

しかしながら上記したこれらの方法では、発光
ダイオードから面状発光する光出力を、全て光フ
ァイバーに入力させることはできず、さらに発光

BEST AVAILABLE COPY

ダイオード、放射器、光ファイバー間の間隙および端面での反射に基づく損失があり、その上結合時の作業性も劣るなどの欠点がある。

本発明は前記の如き従来技術の問題を解決するため、発光ダイオードに、少くともその発光領域以上の面積を底辺に有し、かつ円錐形の結合器を密着させ、その結合器とこれに接続する光ファイバーとを同一の屈折率を有する材料で構成し、これらの結合器と光ファイバーとをスブライシングにより永久接続したものである。

次に本発明の光ファイバー用半導体光装置の一実施例を添付図について説明する。添付図において、発光ダイオード1はn-GaAs(100)面上に通常のエピタキシャル結晶成長法で作られたP型-Ga_{1-x}Al_xAs8を基板として、連続エピタキシャル成長法により、P型-Ga_{1-x}Al_xAs層9およびn型Ga_{1-x}Al_xAs層10を設け、P層9およびn層10の界面に接合部11を形成した後、前記P-Ga_{1-x}Al_xAs基板8内のP⁺拡散層12によつて制限される光の取出し窓13およびオーミック電極2から構

成されている。

光ファイバー5はコア部7およびクラッド部6とで構成され、この光ファイバー5と前記発光ダイオード1とを光学的に結合する。この場合発光ダイオード1の少くとも発光領域、即ち光の取出し窓13以上の面積を底辺部に有する円錐形の、しかも前記光ファイバー5と同一の屈折率を有する珪子材料で結合器4を形成し、この結合器4の底辺部を前記発光ダイオードに密着せしめ、光ファイバー5のコア部7より屈折率の小さい接着剤3で結合する。そして前記結合器4の先端と所定の長さを有する光ファイバー5とは通常のスブライシング技術により接続して、ケース内に固定されているものである。

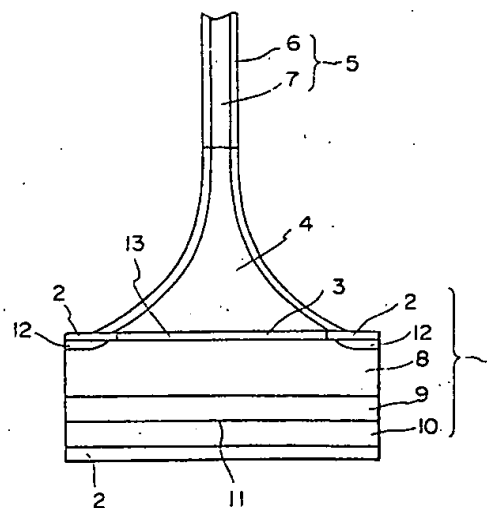
以上述べた如く、本発明の光ファイバー用半導体光装置は、発光ダイオードの光取出し窓13と結合器4とを平面で密着させているので、その接合部で発生した光を有効に利用して結合損失を最小限度に喰い止めることができ、さらに結合器4は実質的に円錐であつて、その先端と光ファイバー

5

5との接続をスブライシングで行なうため、接続損失が殆んどない。そのため従来からの低送光性能の制限が大巾に緩和され、また発光ダイオード1と結合器4との位置設定が従来に比べ簡単になったので装置の製作作業性がよくなる効果がある。図面の簡単な説明

添付図面は本発明の光ファイバー用半導体装置の断面図である。1…発光ダイオード、2…オーミック電極、3…接着剤、4…円錐形結合器、5…光ファイバー、6…クラッド部、7…コア部、8…P-Ga_{1-x}Al_xAs基板、9…P-Ga_{1-x}Al_xAsエピタキシャル層、11…接合部、12…P⁺拡散層、13…光取出し窓。

代理人弁理士 秋 本 正 実



BEST AVAILABLE COPY